3J13 カーボンナノチューブ電界放出カソードにおける 原子状酸素対策の有効性評価

〇島田温子, 井本伸(静岡大学), 大川恭志, 松本康司(JAXA), 田川雅人(神戸大学), 山極芳樹(静岡大学)

Protection of Carbon Nanotube Field Emission Cathode from Atomic Oxygen Atsuko Shimada , Shin Imoto (Shizuoka University), Yasushi Ohkawa, Koji Matsumoto (JAXA), Masahito Tagawa (Kobe University) and Yoshiki Yamagiwa (Shizuoka University)

Key Words: Field Emission Cathode, Carbon Nanotube, Atomic Oxygen

Abstract

An Electrodynamic tether (EDT) is an attractive propulsion device for active debris removal systems. One of the key components of the EDT system is an electron emission device, and we have studied a field emission cathode (FEC) using carbon nanotubes (CNTs) because of its simplicity and potential capabilities. Since EDT systems are operated in low earth orbit (LEO), the CNTs in the FEC may be affected by atomic oxygen (AO), so the effect of AO irradiation on the FEC was studied. Results of the several AO irradiation tests indicated that the electron emission performance declined at a certain level after the irradiation. In order to obtain longer life time, the FEC should be protected and one of the protection measures is the coating of CNT emitter surface by anti-oxidation materials such as SiO_2 or Au. In this paper, the effectiveness of the protection by SiO_2 and Au deposition was described.

1. 序論

近年、低軌道上に存在するスペースデブリが問題 となっている. 今後, 能動的なデブリ除去を実施し ない限り,新たな衛星打上等が無い場合でもデブリ の数は増加することが予測されている¹⁾. 宇宙航空研 究開発機構 (JAXA) では、スペースデブリ除去技術 として導電性テザー (EDT) システム (図 1) の適 用が研究されている. EDT システムとは, テザーと 呼ばれる導電性の紐が地球磁場を横切ることにより 発生する誘導起電力によって電流が生じ、地球磁場 と干渉させることによりローレンツ力を得て推進す る推進システムである. EDT システムの電子放出源 としては, 作動ガスが不要である点や, 低電力動作 が可能である点から電界放出カソード (FEC) が有望 であり,機械的強度に優れる点や,高アスペクト比 を持つ点からカーボンナノチューブ (CNT) 型を採 用している.

デブリ除去ミッションは高度約 600~1000 km 間で 行われる. EDT システムをデブリ除去システムとし て用いる場合, LEO 環境は高密度原子状酸素(AO) 環境であるため AO の衝突によって FEC の電子放出 性能が劣化する懸念がある.



図 1 導電性テザーシステム

そこで我々はこれまでに,LEO での軌道速度相当 の 8 km/s で AO を FEC に照射し,AO による FEC の 電子放出性能変化を調べた²⁾.これにより,以下の結 論が得られた.

- 1) FEC の電子放出性能は原子状酸素の照射により 劣化する.また,CNT 表面が AO 照射方向と平 行に設置されている場合でも性能が劣化する.
- 2)上記の性能劣化の程度は、想定されるデブリ除 去ミッション期間では許容可能なレベルである と予測される.
- 3)ただし、AO 照射後の FEC は長時間動作により 電子放出性能が劣化することが示されたため、 さらなる長寿命化の検討が必要である.

上記より,FEC のさらなる長寿命化に向けた検討を 続ける必要がある.

本研究では、長寿命化の対策として CNT への耐 AO 材料の蒸着を採用した. 耐 AO 材料として知られ る SiO₂および Au を CNT に蒸着することにより, CNT の酸化を防ぎ FEC の劣化が緩和されると考えられる. 一方、蒸着することにより CNT の高アスペクト比が 失われ、初期性能の劣化が生じると考えられる. 蒸 着を行った FEC に対して、先行研究と同様に AO 照 射を行った. AO 照射前後の FEC の電子放出性能を, 電流電圧特性を取得することにより評価した. また, デブリ除去ミッションにおいて有効な対策であるか, 検討を行った.

2. 電界放出カソード (FEC)

電界放出カソードは、電界放出を利用したカソードである.電界放出とは、試料表面に強電場をかけることで、試料表面から電子を放出させる現象である.原理図を図2に示す.試料表面に強い電界が加えられると電子に対するポテンシャル障壁の厚みが非常に薄くなる.電子は波動の性質を持っているため、このようなポテンシャル障壁の中で減衰はするが電子の波は浸透する.つまり、ポテンシャル障壁の他方に、電子の波の振幅があるということになり、電子は見かけ上ポテンシャル障壁を通り抜けることができる.これをトンネル効果という.この現象によって電子放出が行われる.電界放出には、表面電界として10⁹ V/m ほどの高電界が必要である.

電界放出によって得られる電流密度は次式で表さ れる.

$$J = \frac{e^3 F^2}{8\pi h \phi} \exp\left(-\frac{8\pi \sqrt{2m_e}}{3heF}\phi^{3/2}\right)$$
(2.1)

上式を Fowler-Nordheim の式といい, 電界放出の基本 式である.ここで, e は素電荷, h はプランク定数, m_e は電子質量, ϕ は仕事関数, Fは先端の表面電界で ある.このとき, Fは

F = βE (2.2) と表される. このとき β は電界増倍係数, E は電極 間電界である.

FEC は他のカソードに対して,作動ガスが不要, 簡易な構造,低電力での動作が可能というメリット を持つ.一方で,空間電荷制限を受けてしまい,高 圧電源が必要というデメリットを持つが,簡素化が 求められる EDT システムの電子源としてはメリット の方が大きいと考えられる.



図 2 FEC 原理

3. 実験装置及び実験方法

本実験では、AO 照射前後に FEC の電流電圧特性 取得試験を行い、電子顕微鏡 (SEM) で表面観察を 行うことで AO 照射の影響を評価した. AO 照射はレ ーザーデトネーション法により行った. レーザーデ トネーション法とは、Physical Science Inc. により開 発された AO 発生法であり、この方法によって軌道 速度と同じ 8 km/s での AO 照射が可能である. この ときの AO の並進エネルギーは 5 eV である³.

AO 照射方向は, 実際のミッション想定を踏まえて, CNT エミッタ表面に対して平行方向とした. AO 照 射量が 3×10¹⁸, 1×10¹⁹, 3×10¹⁹, 1×10²⁰, 2×10²⁰ /cm² に達した各時点で電流電圧特性を取得した. ここで, "照射量"とは AO の流れに対して垂直方向におけ る単位面積当りの AO 原子数であり,角度方向には 依らない. また,これらの照射量を高度 800 km にお ける AO 照射相当時間で表すと表 1に示す値となる.

FEC の外観を図 3に,構造を図 4に示す.本研究 で用いた FEC は, CNT エミッタ,マスク電極,ゲー ト電極,シールドからなり,ゲート電極はスペーサ ーによりエミッタ,マスク電極およびシールドと絶 縁されている. FEC は SiO₂蒸着 FEC, Au 蒸着 FEC および蒸着無し FEC の計 3 台を用いる. 蒸着を行っ た FEC の各々の蒸着膜厚は, SiO₂蒸着が 11 Å, Au 蒸着が 15 Åである. 電流電圧特性取得実験の回路図 を図 5に示す. エミッタを接地し, ゲートに正電圧 を印加することにより, 電流電圧特性を取得した.

照射量[/cm ²]	高度 800km における 照射相当時間 [日]
2×10^{20}	1000
1×10^{20}	500
3×10 ¹⁹	150
1×10^{19}	50
3×10 ¹⁸	15

表 1 照射条件



図 3 FEC 外観







図 5 実験回路図

4. 実験結果

4.1. 電流電圧特性比較

AO 照射前後の電流電圧特性を図 6に示す. このと き, AO 照射後の電流電圧特性は 2×10²⁰ /cm²照射後 に取得したものである.また,図中凡例の w/o.C は 蒸着を行っていないFEC, AuはAu蒸着を行ったFEC, SiO₂は SiO₂蒸着を行った FEC を示し,before, after はそれぞれ AO 照射前, AO 照射後を示す.図 6より, どの FEC も AO 照射後では, AO 照射前に比して電 流電圧特性が高電圧側にシフトしていることがわか る.これにより,蒸着されている FEC であっても AO による劣化が生じることが示された.しかし,初 期性能に個体差があるものの, AO 照射後の電流電圧 特性を比較すると,蒸着をしていない FEC に比べ, 蒸着を行った FEC の性能の方が良いことがわかる. したがって,今回の蒸着よって少なくともある程度 の FEC 性能劣化対策の効果があると考えられる.





4. 2. AO 照射量と閾値電圧の変化

図 7, 図 8に, AO 照射量に対する閾値電圧の変化, AO 照射前閾値電圧に対する閾値電圧比の変化をそ れぞれ示す.ここで閾値電圧とは、電界電子放出が 始まる最低の電圧を指し、この値が小さいほど電子 放出しやすいことを示す.図 8の縦軸は、AO 照射前 の閾値電圧に対する各照射量時の閾値電圧の比であ り、FEC の個体差を考慮した指標である.図 7より, 蒸着の有無に関わらず FEC の閾値電圧は AO が照射 されるほどに増加していることがわかる.また、Au 蒸着 FEC の閾値電圧が一見高く、蒸着の効果が無い ように見られるが、図 8より、Au 蒸着 FEC の電圧増 加は、SiO2蒸着 FEC と同様に抑えられていることが わかる.





図 8 AO照射前閾値電圧に対する閾値電圧比の変化

4. 3. CNT エミッタ表面観察

フルエンス 2×10²⁰/cm²の AO 照射を行った FEC に 対して SEM による表面観察を行った. 図 9に Au 蒸 着 FEC の SEM 画像を,図 10に SiO₂蒸着 FEC の SEM 画像を示す. 図中の白い糸状のものが CNT であり, 比較的大きな粒子系のものは基板と CNT を接着する ための接着剤である. AO に曝されていない非照射部 と AO に曝された照射部の観察を行ったが,図に示 されるように歴然とした差が無いことがわかる. こ のとこから, AO 照射による電子放出性能の劣化は, SEM で識別できるような幾何形状の変化に起因する



図 9 Au 蒸着 FEC の SEM 画像:(a) 照射部,(b) 非照射部



図 10 SiO₂蒸着 FEC の SEM 画像:(c) 照射部, (d) 非照射部

ものではなく, AO の吸着等が原因であると考えられ, そのメカニズムに関しては現在調査中である.

ここで、蒸着の様子に着目する.比較のために、 蒸着を行っていない FEC の SEM 画像を図 11に示す. 蒸着を行った CNT の SEM 画像(図 9,図 10)と蒸 着を行っていない CNT の SEM 画像(図 11)を比較 すると、Au および SiO₂が CNT に粒子形状でまばら に蒸着していることがわかる.これは、AO の照射部、 非照射部に関わらず観察された.また、Au を CNT に蒸着させると、Au は粒子形状でまばらに CNT に 蒸着することが報告されている⁴⁾.3項に示したとお り、成膜条件としては SiO₂蒸着が 11 Å、Au 蒸着が 15 Åとして蒸着を行ったが、上記の点より、CNT は 耐 AO 材料によって一様に覆われていない状態であ ることがわかった.



図 11 蒸着を行っていない FEC の SEM 画像

5. 考察

実験結果から, CNT エミッタ表面への耐 AO 材料 の蒸着により, FEC の劣化を抑えられることが示さ れた.ここでは,蒸着の効果の持続性に関して考察 する.EDT システムによる低軌道デブリ除去システ ムでは,長期間のミッションが想定されている⁵⁾.し たがって, AO 保護対策として蒸着の効果に持続性が 求められる.

図 12に単位 AO 照射量当たりの閾値電圧増加率の 変化を示す.この指標は、各照射量時点での閾値電 圧を1つ前の時点での閾値電圧で除した値であり、 ある AO 照射区間における電圧の増加率が単位照射 量当たりどの程度であるかを示している.

図 12より, 照射量が 3×10¹⁸/cm²の時点では蒸着を 行った FEC の単位照射量当たりの電圧増加率は, 蒸 着を行っていない FEC の増加率に対して小さいこと がわかる.つまり蒸着の効果が顕著に現れている.

このとき、蒸着無し FEC の増加率に対して Au 蒸着 FEC の増加率は約 89 % である. 同様に SiO2 蒸着 FEC の増加率は蒸着無し FEC の約 80%である.一方, 1×10¹⁹/cm²の時点では, Au, SiO2蒸着 FEC の増加率 は蒸着無し FEC の約 93 % であり, 3×10¹⁹ /cm²の時点 では蒸着無しFECと蒸着FECの電圧増加率はほぼ同 じになることがわかる.これは、 1×10^{19} /cm² から 3×10¹⁹/cm²間の照射では、どの FEC も同様に劣化し ていることを示している.したがって、この時点で 蒸着による FEC 保護の効果は無くなったと考えられ る.また,その後の照射による電圧増加率を見ると, 蒸着を行った FEC の電圧増加率が蒸着無し FEC の電 圧増加率を上回るという結果を示している.これは、 蒸着により保護されていた CNT がむき出しになった ことにより、これまで劣化していなかった箇所が劣 化し始めた為と示唆されるが,差が微小であるため, 今後の詳細評価が必要である.

さらに、4.3. で示した SEM 画像から、Au およ び SiO₂が CNT にまばらに蒸着されていた点も持続性 に影響していると考えられ、蒸着材料の選定や CNT のコーティング方法などの検討を行う必要がある.

以上により,蒸着による AO 対策効果の持続性は 見込めないといえる.しかし,実験結果でも示した ように,初期の劣化が抑えられるため引出電圧が高 電圧になることを防ぐことが可能であるといえる.



図 12 単位 AO 照射量当たりの閾値電圧増加率

6. 結論

LEO 軌道上に存在する原子状酸素によるカーボン ナノチューブ電界放出カソードの性能劣化を防ぐこ とを目的とし, CNT 表面に耐 AO 材料の蒸着を行っ た FEC に対して原子状酸素を照射し性能評価を行っ た. 蒸着を行うことにより,引出電圧の高電圧化を 防ぐことができるが,一方で蒸着の効果は初期の段 階で失われる可能性があることが示された.今後, 蒸着材料の選定や CNT のコーティング方法の検討, 蒸着膜厚の変更などにより,評価を継続する予定で ある.

参考文献

- J. –C. Liou, and N. L. Johnson.: Risks in Space from Orbiting Debris, Science, Vol.311, pp. 340-341, 2006.
- 2) Shimada, A., Tanaka, Y., Ohkawa, Y., Matsumoto, K., Tagawa, M., Matsui, M. and Yamagiwa, Y.: Effect of Atomic Oxygen Irradiation on Field Emission Cathodes in Low Earth Orbit, Trans. JSASS Space Tech, Vol.12, No.ists29, pp.Pb_59-Pb_64, 2014.
- Shimamura, H., Baba, S. and Miyazaki, E.: Handbook of the Combined Space Effect Test Facility, JAXA-RM-10-013, 2011.
- Y. Zhang, Nathan W. Franklin, Robert J. Chen, Hongjie Dai.: Metal coating on suspended carbon nanotubes and its implication to metal-tube interaction, Chemical Physics Letters, Vol.331, 1, pp.35-41, 2000.
- Kawamoto, S., Ohakawa, Y., Kitamura, S. and Nishida, S.: Strategy for active debris removal using electrodynamic tether, Trans. JSASS Space Tech. Vol. 7, No.ists26, pp. Pr_2_7-Pr_2_12, 2009.